133ЛН3А, Микросхема полупроводниковая

133ЛН3А — цифровая микросхема технологии ТТЛ 133-ей серии, являются транзисторно матлогикой с функционалом шесть инверторов с повышенным коллекторным напряжением и используются в РЭА в большой области эксплуатации. Микросхемы изготовлены в керамометаллическом корпусе и выпускаются в корпусе 401.14-32, вес не превышает 1г. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически Микросхемы 2) согласована техусловиям ТТ/И63.088.023 ТУ41.

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основных электрических параметров:

Наименование параметра 133ЛН3А, единица замера, режим замера	Обозначение буквами	Допуск	
		больше	меньше
Вольтаж на выходе низшего значения, V (Ucc=5V+-10%, I o=16mA, U IL= 2V)	U OL		0,4
Ампераж на выходе при высшем значении, uA (UIL=0,8V UO=5,5V, UIH= 4,5V UCC= 5V+-10%)	I OH		225
Ампераж на входе низшего значения, mA (Ucc=5V+-10%, U IH= 4,5V, U IL= 0,4V)	I IL		/-1,6/
Ампераж на входе высшего значения, mA (Ucc=5V+-10%, U IH= 2,4V, U IL= 0V)	I IH		0,04
Ампераж на входе при максимальном вольтаже на входе, mA	I IH1		1
Ампераж потребления, mA	I CC		47

Примечания:
1. Параметрами-критериями годности в течение минимальной наработки и срока сохранности являются U OL, I IH, I OH.
2. Знак МИНУС перед обозначениями токов указывает только на его направление

Предельные 133ЛН3А параметры

Напряжение питания U cc больше 4,5V и меньше 5,5V.
Время фрона нарастания и время фронта спада сигнала меньше 150ns.